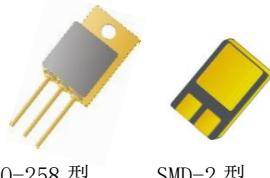




LYCS56N100 型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

1 特性

- 开关速度快、损耗小，输入阻抗高，驱动功耗小，安全工作区宽，温度稳定性好；
- 静电敏感等级：1A 级；
- 封装形式：TO-258/SMD-2。



TO-258 型 SMD-2 型

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611，Q/RBJ1005QZ。

3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数 产品型号	P_D^a ($T_c=25^\circ\text{C}$) W	V_{GS} V	I_{DM1} ($T_c=25^\circ\text{C}$) A	I_{DM2} ($T_c=100^\circ\text{C}$) A	$R_{th(j-c)}$ °C/W	T_j °C	T_{stg} °C	封装 形式
LYCS56N100(R)T	125	±20	56	40	1	-55~+150	-55~+150	TO-258
LYCS56N100(R)U								SMD-2

^a 当 T_c 超过 25°C 时，按 $1.0\text{W}/^\circ\text{C}$ 线性降额。

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
1	漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=1\text{mA}$	100	—	—	V
2	开启电压	$V_{GS(\text{th})}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	—	4.0	V
3	导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=40\text{A}$	—	—	20	$\text{m}\Omega$
4	零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=100\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	—	25	μA
5	正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	100	nA
6	反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	100	nA
7	开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=50\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, I_D=45\text{A}, R_g=4.5\Omega$	—	27	—	ns
	上升时间	t_r		—	36	—	ns
	关断延迟时间	$t_{d(off)}$		—	36	—	ns
	下降时间	t_f		—	9	—	ns
8	栅电荷	Q_g	$V_{DD}=50\text{V}, I_D=56\text{A}$ $V_{GS}=10\text{V}$	—	56	—	nC
		Q_{gs}		—	21	—	nC
		Q_{gd}		—	6	—	nC
8	电容	C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	6074	—	pF
		C_{oss}		—	1391	—	pF
		C_{rss}		—	1348	—	pF



5 特性曲线

